

Silicon Diode

BA136

VHF Band Switch

50V / 100mA

DATASHEET

OEM – Siemens

Source: Siemens Databook 1970/71

BA 136, BA 136 A

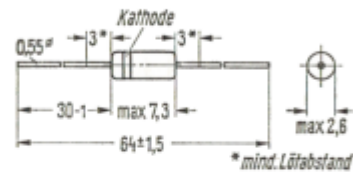
Nicht für Neuentwicklung

Silizium-Planar-Schalter-Diode für den VHF-Bereich

BA 136 und BA 136 A sind diffundierte epitaktische Silizium-Dioden in Planar-technik im Glasgehäuse 51 A 2 DIN 41880 (DO-7).

Sie sind besonders zur Bereichsumschaltung in VHF-Tunern geeignet. Die Typenbezeichnung ist am Diodengehäuse aufgestempelt, die Kathode wird durch einen Farbring gekennzeichnet.

Typ	Bestellnummer
BA 136	Q60201-X136
BA 136 A	Q60201-X136-A



Grenzdaten		BA 136	BA 136 A	
Sperrspannung	U_R	50	50	V
Durchlaßstrom	I_F	100	100	mA
Sperrschichttemperatur	T_j	125	125	°C
Umgebungstemperatur	T_U	-55 bis +125	-55 bis +125	°C
Gesamtverlustleistung	P_{tot}	160	160	mW
Wärmewiderstand				
Sperrschicht – Luft	R_{thJU}	≤ 500	≤ 500	grad/W

Statische Kenndaten ($T_U = 25^\circ\text{C}$)

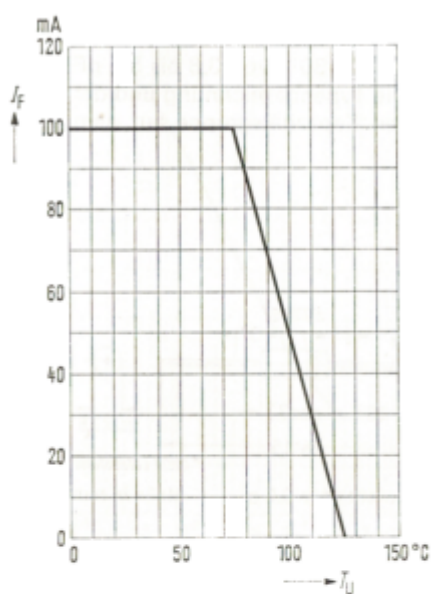
Durchlaßspannung ($I_F = 100\text{ mA}$)	U_F	< 1	< 1	V
Sperrstrom ($U_R = 30\text{ V}$)	I_R	< 100	< 100	nA

Dynamische Kenndaten ($T_U = 25^\circ\text{C}$)

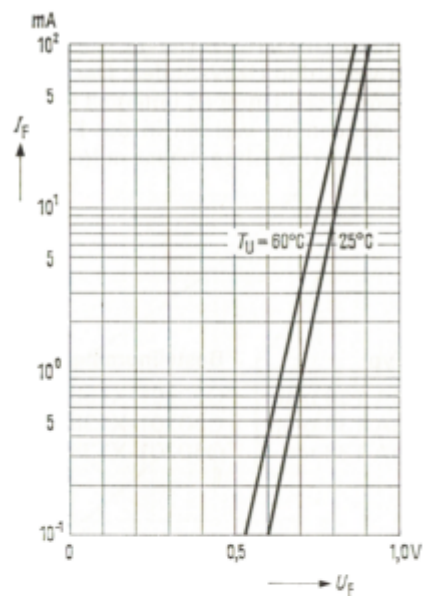
Diodenkapazität ($U_R = 30\text{ V}$; $f = 1\text{ MHz}$)	C_D	0,9 (< 2)	1,3 (< 2)	pF
Dynamischer Durchlaßwiderstand ($I_F = 100\text{ mA}$; $f = 1\text{ kHz}$)	r_t	0,45	0,45	Ω
($I_F = 10\text{ mA}$; $f = 100\text{ MHz}$)	r_t	< 1	< 0,6	Ω

BA 136, BA 136 A

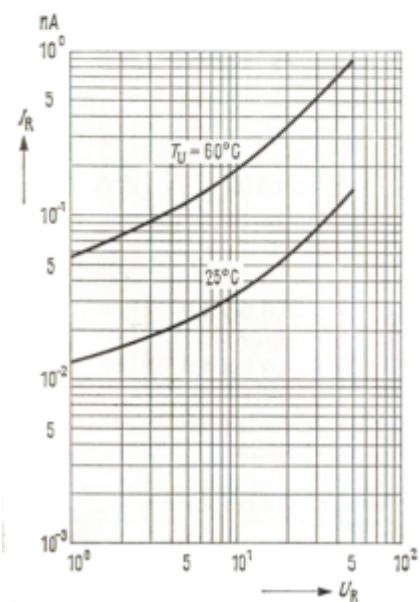
Maximaler Durchlaßstrom
 $I_F = f(T_U)$



Durchlaßkennlinie $I_F = f(U_F)$
 $T_U = \text{Parameter}$



Sperrkennlinie $I_R = f(U_R)$
 $T_U = \text{Parameter}$



Spannungsabhängigkeit der
Sperrschichtkapazität $C_D = f(U_R)$

